

第3章 静磁場

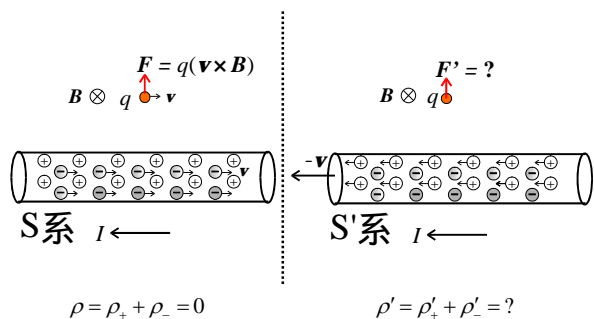
ローレンツ力 (復習)

速度 \mathbf{v} で運動している電荷 q が位置 \mathbf{r} で受ける力は

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q(\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}))$$

と表せることが経験的にわかっている。この電荷に働く力をローレンツ力と呼び、 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ を電場、 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ を磁場と定義する。

力の起源: 電場or磁場?



ローレンツ収縮による導線の帯電

S系では、自由電子は速度 v で動いているので、自由電子の平均的間隔は止まっている場合 (S'系) の間隔の $\sqrt{1-v^2/c^2}$ 倍にローレンツ収縮している

$$\rho_- = \frac{\rho'_-}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \Leftrightarrow \rho'_- = \rho_- \sqrt{1-v^2/c^2} \cong \rho_- \left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right)$$

S'系では、原子核は速度 v で動いているので、原子核の平均的間隔は止まっている場合 (S系) の間隔の $\sqrt{1-v^2/c^2}$ 倍にローレンツ収縮している

$$\rho'_+ = \frac{\rho_+}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \cong \rho_+ \left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right)$$

従って、

$$\rho' = \rho'_+ + \rho'_- \cong \rho_+ \left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right) + \rho_- \left(1 - \frac{v^2}{2c^2}\right) = \rho_+ \frac{v^2}{c^2}$$

S系において、電荷 q に働く力は、狭義のローレンツ力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} = -qv\mathbf{e}_1 \times \mathbf{B}$$

S'系において、電荷 q に働く力は、クーロン力

$$\mathbf{F}' = q\mathbf{E}' = \frac{q\rho'A}{2\pi\epsilon_0 r} \mathbf{e}_r = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\rho_+ vA}{r} v\mathbf{e}_r = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{I}{r} v\mathbf{e}_r$$

両者は同じであろうから (電荷はどちらの系でも上向きに加速されるから)、

$$-qv\mathbf{e}_1 \times \mathbf{B} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{I}{r} v\mathbf{e}_r$$

$\mathbf{B} \perp \mathbf{e}_1$ と仮定すると

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{I}{r} \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_r$$

近似を用いない厳密な議論は
ファイマン物理学III「電磁気学」
p166 (電磁場の相対性) を参照のこと

電流が作る磁場

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0 c^2} \frac{I}{r} \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_r$$

ここで定数 $\mu_0 \equiv \frac{1}{\epsilon_0 c^2}$ を導入すると、

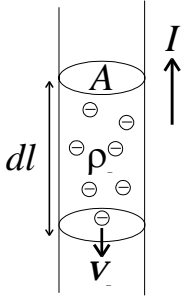
$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_r$$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m : 真空の透磁率 (定義値)

$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} = 8.8541878 \times 10^{-12}$ F/m : 真空の誘電率 (定義値)

(真空中の光速: $c = 299,792,458$ m/s (定義値))

電流に働くローレンツ力



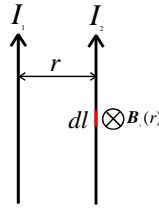
$$\mathbf{v}_- = \frac{\mathbf{j}}{\rho_-} = \frac{I}{\rho_- A} \mathbf{e}_I$$

$$dQ = \rho_- A dl$$

$$d\mathbf{F} = dQ \mathbf{v}_- \times \mathbf{B} = \rho_- A dl \frac{I}{\rho_- A} \mathbf{e}_I \times \mathbf{B}$$

$$= \mathbf{I} \times \mathbf{B} dl \quad (\mathbf{I} = I \mathbf{e}_I)$$

電流間に働く力



$$\mathbf{B}_1(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_r$$

$$d\mathbf{F} = \mathbf{I}_2 \times \mathbf{B}_1 dl$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} \mathbf{e}_I \times (\mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_r) dl$$

$$= -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} (\mathbf{e}_I \cdot \mathbf{e}_I) \mathbf{e}_r dl$$

電流が同じ(逆)向きなら、引力(斥力)

$$I_1 = I_2 = 1 \text{ A}, r = dl = 1 \text{ m}$$

$$|d\mathbf{F}| = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7} \text{ N (電流の定義)}$$

電場と磁場の法則のアナロジー

クーロンの法則

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dl$$

ビオ・サバルの法則

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dl$$



線電荷密度の無限に長い棒が作る電場

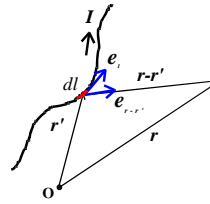


電流Iの無限に長い導線が作る電場

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} \mathbf{e}_r$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_r$$

ビオ・サバルの法則



$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dl$$

$d\mathbf{I} \equiv I \mathbf{e}_I dl$ と定義すれば、

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{I} \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}$$

連続的な電流分布への拡張

クーロンの法則

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dl$$

$$\lambda dl \leftrightarrow \rho(\mathbf{r}') dV'$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dV'$$

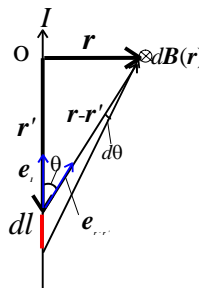
ビオ・サバルの法則

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dl$$

$$I \mathbf{e}_I dl \leftrightarrow \mathbf{j}(\mathbf{r}') dV'$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} dV'$$

無限に長い直線電流の作る磁場



$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} dl$$

$$\mathbf{e}_I \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} = \mathbf{e}_\phi \sin \theta \quad |\mathbf{r}-\mathbf{r}'| = R$$

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \theta dl}{R^2} \mathbf{e}_\phi$$

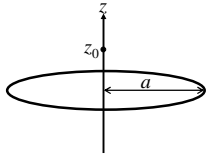
$$\sin \theta dl = R d\theta \quad \sin \theta = r/R$$

$$d\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \theta d\theta}{r} \mathbf{e}_\phi$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\pi \frac{\sin \theta}{r} \mathbf{e}_\phi d\theta = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \mathbf{e}_\phi$$

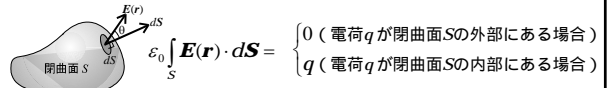
第3章レポート問題1

半径 a の円形回路に、電流 I が流れている。円の中心における磁場の大きさをビオ - サバルの法則を用いて計算せよ。余裕のあるものは、この円形回路の中心軸(z 軸)上の任意の位置 $z = z_0$ における磁場の大きさを求めよ。

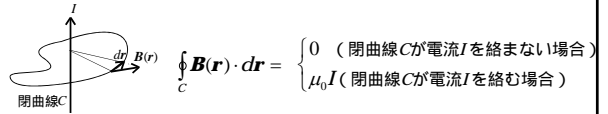


ガウスの法則とアンペールの法則

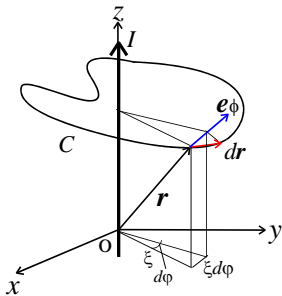
ガウスの法則



アンペールの法則



無限に長い直線電流の場合



電流が作る磁場は、

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi \xi} \mathbf{e}_\phi$$

よって、経路Cにおける循環は、

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I \oint_C \frac{1}{2\pi \xi} \mathbf{e}_\phi \cdot d\mathbf{r}$$

$$\mathbf{e}_\phi \cdot d\mathbf{r} = \xi d\phi \text{ と表せるので}$$

$$\mu_0 I \oint_C \frac{1}{2\pi \xi} \xi d\phi = \mu_0 I \oint_C \frac{d\phi}{2\pi}$$

アンペールの法則

複数の電流回路がある場合

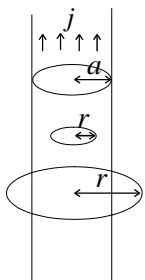
$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \sum_{\text{経路 } C \text{ が絡む}} I_i$$

電流が電流密度 $j(\mathbf{r})$ で分布している場合

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$$

アンペールの法則の応用例

半径 a の無限に長い円柱状導体内を一樣な電流密度 j で流れる電流が作る磁場

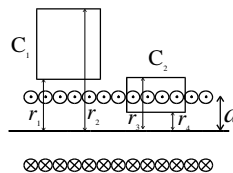


i) $0 \leq r \leq a$ の場合

ii) $r > a$ の場合

アンペールの法則の応用例

1mあたりの巻き数が n である半径の無限に長いソレノイドコイルに、電流 I を流したときにできる磁場

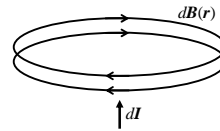


第3章レポート問題2

ソレノイドコイルの中心の磁場の大きさを、
 ビオ・サバルの法則を用いて計算せよ
 (第3章レポート問題1参照)。アンペールの
 法則を用いて得られた結果と一致した
 か？

磁場の湧き出し

ビオ・サバルの法則より、電流要素 $d\mathbf{l}$ は回転対称な
 (トーラス型の)磁場を作る



どのような閉曲面 S をとっても、 $\int_S d\mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$

磁場の重ね合わせの原理より、一般に $\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$

これまでのまとめ

時間変化しない電磁場(静電場、静磁場)の基本法則

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q(\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \quad (\text{ローレンツカ})$$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'} dV' \Leftrightarrow \begin{cases} \epsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV & (\text{電場のガウスの法則}) \\ \oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 0 & (\text{循環ゼロの法則}) \end{cases}$$

(クーロンの法則) 境界条件(無限遠で電場がゼロに収束)

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} dV' \Leftrightarrow \begin{cases} \oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} & (\text{アンペールの法則}) \\ \int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0 & (\text{磁場のガウスの法則}) \end{cases}$$

(ビオ・サバルの法則) 境界条件(無限遠で磁場がゼロに収束)

微分系への準備 その 1 : ガウスの定理

$$\int_S \mathbf{v}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) dV$$

$$\nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\partial v_x(\mathbf{r})}{\partial x} + \frac{\partial v_y(\mathbf{r})}{\partial y} + \frac{\partial v_z(\mathbf{r})}{\partial z} \quad (\equiv \text{div } \mathbf{v}(\mathbf{r}))$$

「 $\nabla \cdot$ 」または「div」は「ダイバージェンス(divergence)」と読む

微分系への準備 その 2 : ストークスの定理

$$\oint_C \mathbf{v}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{v}(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \times \mathbf{v}(\mathbf{r}) \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial v_z(\mathbf{r})}{\partial y} - \frac{\partial v_y(\mathbf{r})}{\partial z} & \frac{\partial v_x(\mathbf{r})}{\partial z} - \frac{\partial v_z(\mathbf{r})}{\partial x} & \frac{\partial v_y(\mathbf{r})}{\partial x} - \frac{\partial v_x(\mathbf{r})}{\partial y} \end{pmatrix}$$

($\equiv \text{rot } \mathbf{v}(\mathbf{r})$)

「 $\nabla \times$ 」または「rot」は「ローテーション(rotation)」と読む

ガウスの法則の微分形

ガウスの定理(数学) ガウスの法則(物理)

$$\int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) dV$$

$$\epsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) dV = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

任意の体積 V で上の式が成り立つためには、積分の中身は
 同じでなければならないので、

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$$

アンペールの法則の微分形

ストークスの定理 (数学) アンペールの法則 (物理)

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_V (\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\int_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r})) \cdot d\mathbf{S} = \int_S \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$$

任意の閉曲面 S で上の式が成り立つためには、積分の中身は同じでなければならないので、

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r})$$

静電磁場の基本法則

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q(\mathbf{E}(\mathbf{r}) + \mathbf{v} \times \mathbf{B}(\mathbf{r}))$$

< 微分形 >

$$\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{j}(\mathbf{r})$$

< 積分形 >

$$\varepsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

$$\oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S}$$

マクスウェル方程式

時間変化する電磁場の基本方程式

$$\varepsilon_0 \int_S \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \int_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

$$\oint_C \mathbf{E}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{r})}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_C \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 \int_S \left(\mathbf{j}(\mathbf{r}) + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{r})}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\int_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$